

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

2SA497, 2SA498

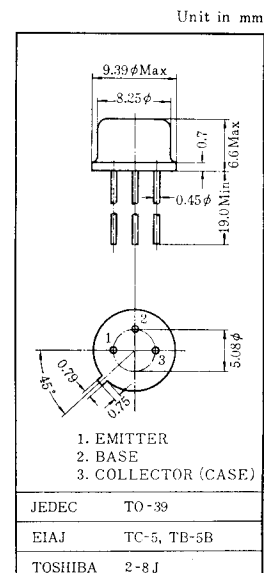
○中電力増幅用

○ Medium Power Amplifier Applications.

- 高耐圧です $V_{CEO} = -80V$ 2SA497
 $V_{CEO} = -50V$ 2SA498
- 飽和電圧が低い $V_{CE(sat)} = -0.12V$ (Typ.)
- 2SC497, 2SC498 とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC497 and 2SC498

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-80	V
		-50	
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
		-50	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-800	mA
エミッタ電流	I_E	800	mA
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合温度	T_J	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -30V, I_E = 0$	—	—	1.0	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-80	—	—	V
			-50	—	—	
エミッタ・ベース間電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -1mA, I_C = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	(NOTE) $h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -200mA$	40	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -800mA$	13	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -200mA, I_B = -20mA$	—	-0.12	-0.8	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -200mA, I_B = -20mA$	—	-0.9	-1.2	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_E = 10mA$	—	70	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	33	—	pF

Note: $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA497 and 2SA498 are classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA497—R 2SA498—R	40	80
2SA497—O 2SA498—O	70	140
2SA497—Y 2SA498—Y	120	240